

	吉松秀格
25. $K_2Ba(NO_2)_4$ の凍結された無秩序状態の秩序化過程	米川友弘
26. 超低周波領域における磁氣的揺動の観測 — グラファイト層間化合物を中心にして —	米沢岳志
27. W(100), Ni(110) 表面吸着水素の昇温脱離	渡辺佳英
28. Si の照射誘起二次欠階の研究	華国春
29. 多層膜超伝導体 Nb-Cu の NMR による研究	鄭国慶
30. YMn_2 の擬二元化合物におけるスピンのゆらぎと熱膨張	中村裕之
31. 一次元格子上の脱離・吸着の速度論	坂野齋

1. 高密度近藤系 $CeCu_2Si_2$ の核磁気共鳴による研究

飯田晴久

高密度近藤系と呼ばれる物質の1つである $CeCu_2Si_2$ は 0.7 K 付近で、超伝導に転移し、その超伝導は重い電子系の超伝導として注目を集めている。

この $CeCu_2Si_2$ について我々の研究室においては、先に $T_c \sim 0.72$ K (T_c は超伝導転移温度) という試料に対して核磁気緩和時間 T_1 の測定が行なわれ、通常の BCS 型超伝導体とは異なる T_1 の温度依存性が見出された。

しかしながら $CeCu_2Si_2$ においては、 T_c や比熱、帯磁率等に、大きな試料依存性が見られることが報告されている。したがって T_c や他の物理的性質が異なる試料についても超伝導状態での T_1 を測定し、先に得られた結果が、どの程度 $CeCu_2Si_2$ の超伝導本来の性質を反映しているのかを調べる必要があると思われる。

このような目的で $T_c \sim 0.6$ K, $T_c \sim 0.65$ K という試料に対して、0.3 K までの温度範囲で、 T_1 の測定を行なった。その結果

- (1) T_c よりすぐ下の温度では、BCS 型超伝導体で見られるような T_1 が一旦短くなる現象が見られない。
- (2) T_c より十分下の温度では、 $1/T_1$ の温度依存性は指数関数的でなく、むしろ T^3 に比例している。

というような、先に、 $T_c \sim 0.72\text{K}$ の試料について見られたのと類似の T_1 の温度依存性を得た。

この結果は、 CeCu_2Si_2 では、超伝導のエネルギーギャップが、フェルミ面のある方向で消えている異方的な超伝導が実現していることを強く支持するものである。

2. 薄膜中の励起子ポラリトン —付加的境界条件問題の研究—

石 原 一

励起子共鳴域等の空間分散性の媒質に光が入射した時、結晶中の固有モード（ポラリトン）としては（誘電関数に波数依存性があるため）、1つの振動数 ω に対して異なる波数を持つ複数のモードが現われる。このため結晶表面で外部光の電界と一意的な接続をするための境界条件としては Maxwell の境界条件以外にさらに付加的境界条件（Additional Boundary Condition ; ABC）が必要となる。

張一川田（C-K）は D'Andreu-DelSole（DA-DS）によるマイクロなモデル（励起子波動関数に $\exp(-pz)$ 型の減衰波の寄与を考慮する。）を薄膜に応用し、ABC の計算をした。この際、分極率の計算に現われる量子化波数 k についての和を実行するにわたって、減衰定数 p 、膜厚 d 、及び励起子波数 q の間に、 $pd \gg 1$ 、 $p \gg |q|$ の関係を仮定した。

今回、上述の k の和を、複素積分におきかえることにより、 $\exp(-pd) \cong 0$ という仮定だけを用いて、分極率を厳密に計算し、C-K の結果を拡張した。この場合も Maxwell の微分方程式を解析的に解き、ABC および電場の表式を求めることができる。これによって反射率、透過率等の計算への適用範囲が、 $pd \gg 1$ 、 $p \gg |q|$ を満たさない場合にも拡張され、また C-K の計算における近似の誤差を解析的に評価することができた。

一方、同じ Maxwell 方程式から出発して ABC を径由せず直接電場の表式を求める方法が ABC-free 理論として張により示された。この方法では分極率を閉じた形で求めず、積分核の簡単な形を利用して二階の微分方程式を解くため、電場は2つの任意定数のみを含む形で求まり、ABC の議論を必要としない。後半ではこの理論を DA-DS のモデルに応用、 $d \rightarrow \infty$ 及び $d < \infty$ の場合での計算をし、それが ABC 理論と同じ結果を与えることを示した。